

Silicon NPN Transistor

BU508D

1500V / 8A

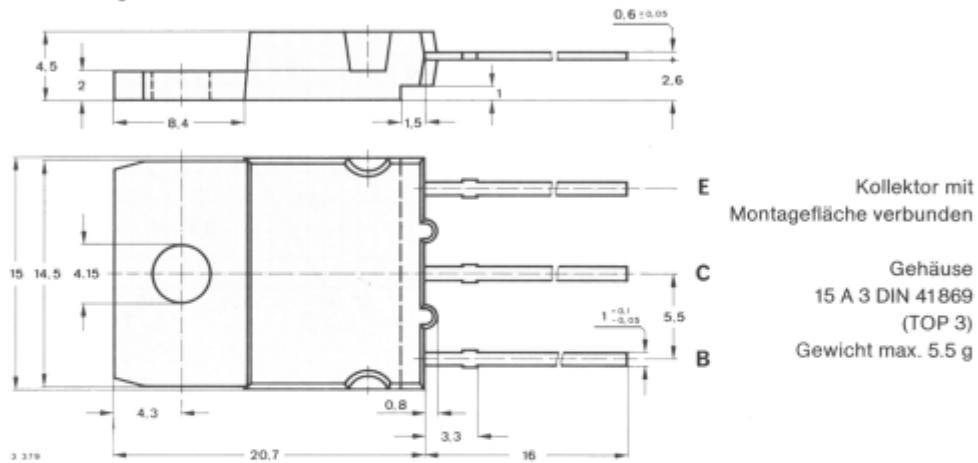
DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985&89

BU 508 D**Silizium-NPN-Leistungstransistoren****Anwendung:** Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfängern**Besondere Merkmale:**

- In Dreifachdiffusions-Technik
- Kurze Schaltzeiten
- Glaspassivierung
- Hohe Spitzenleistung
- Hohe Sperrspannung
- Verlustleistung 125 W
- Monolithisch integrierte Inversdiode

Abmessungen in mm**Zubehör**

Isolierscheibe Best. Nr. 191 131
Montageclip Best. Nr. 191 940

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Sperrspannung	U_{CEO}	700	V
	U_{CES}	1500	V
Kollektorstrom, Mittelwert	I_{CAV}	8	A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	15	A
Basisstrom, Mittelwert	I_{BAV}	4	A
Basispitzenstrom	I_{BM}	6	A
Negativer Basispitzenstrom	$-I_{BM}$	2.5	A
Gesamtverlustleistung $T_{case} \leq 25\text{ °C}$	P_{tot}	125	W
Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-65 ... +150	°C

BU 508 D

Wärmewiderstand		Min.	Typ.	Max.	
Sperrschicht-Gehäuse	R_{thJC}			1.0	K/W
Kenngroßen					
$T_{case} = 25\text{ °C}$					
Kollektor-Emitter-Reststrom $T_J = 125\text{ °C}, U_{CES} = 1500\text{ V}$	I_{CES}			2	mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 1\text{ mA}$	$U_{(BR)CES}$	1500			V
$I_C = 100\text{ mA}, L_C = 125\text{ mH}$	$U_{(BR)CEO}^{1)}$	700			V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 100\text{ mA}$	$U_{(BR)EBO}$	5			V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 4.5\text{ A}, I_B = 2\text{ A}$	$U_{BEsat}^{1)}$			1.5	V
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis $U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 2.5\text{ A}$	h_{FE}	4.5			
$I_C = 4.5\text{ A}$	h_{FE}		3.2		
Diodendurchlaßspannung der integrierten Schutzdiode $I_F = 4\text{ A}$	U_F			1.5	V
Transitfrequenz $U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 100\text{ mA}, f = 5\text{ MHz}$	f_T		7		MHz
Kollektor-Basis-Kapazität $U_{CB} = 10\text{ V}, I_C = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_{CBO}		125		pF

¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0.01, t_p = 0.3\text{ ms}$

BU 508 D